PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 60097356 A(43) Date of publication of application: 31.05.1985

(51) Int. Cl G03F 1/00

(21) Application number: 58204803 (71) Applicant: HITACHI LTD

(22) Date of filing: 02.11.1983 (72) Inventor: KOIZUMI YASUHIRO

(54) PHOTOMASK

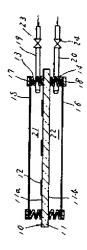
(57) Abstract:

PURPOSE: To prevent transfer of foreign matter and to improve the yield of a semiconductor product and working efficiency by controlling the air pressure in the hermetic space formed between the surface of a photomask, frames and shielding films thereby changing the space.

CONSTITUTION: Bellows-like frames 13, 14 are attached to the peripheral part on the front and rear of a photomask 10 formed with a light non-transmittable film 12 on the surface of a transparent base plate 11 and respective thin transparent shielding films 15, 16 are extended at the other end edges thereof. Air is supplied into the hermetic spaces formed among th photomask 10, the frames 13, 14 and the films 15, 16 inbetween to make the space thereof variable. The space is made large in the stage of exposing to put foreign matter to the outside of the depth of focus even if such foreign matter sticks on the shielding films, thereby preventing transfer and generation of a defect

and improving the yield of the semiconductor. The space is decreased to attain tight contact in the stage of inspecting the appearance of the mask 10. The automatic inspection is thus made possible without generation of the deviated focus of the optical system of an inspecting machine by the shielding films and the working efficiency is improved.

COPYRIGHT: (C)1985,JPO&Japio



⑲ 日本国特許庁(JP)

⑪特許出願公開

⑩ 公 開 特 許 公 報 (A) 昭60-97356

⑤Int.Cl.⁴

識別記号

庁内整理番号

❸公開 昭和60年(1985)5月31日

G 03 F 1/00

V-7447-2H

審査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

🖾発明の名称

ホトマスク

②特 願 昭58-204803

❷出 願 昭58(1983)11月2日

⑫発 明 者

古泉 裕弘

小平市上水本町1450番地 株式会社日立製作所武蔵工場内

⑪出 願 人 株式会社日立製作所

東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地

砂代 理 人 弁理士 高橋 明夫

外1名

明細 種

発明の名称 ホトマスク

特許請求の範囲

1. ホトマスクにその高さが可変なフレームを取 着すると共に、このフレームには前記パターンを カパーする透明な遮蔽膜を張設し、前記ホトマス クの表面と遮蔽膜との間隙を変化できるように構 成したことを特徴とするホトマスク。

2. ホトマスク表面、フレームおよび遮蔽膜との 間に気密空間を画成し、この気密空間の空気圧を コントロールして前記間膜を変化させてなる特許 請求の範囲第1項記載のホトマスク。

3. フレームを蛇腹状に形成すると共に、空気コントローラに接続したチュープをフレームに開口 連通させてなる特許請求の範囲第2項記載のホト マスク。

発明の詳細な説明

〔技術分野〕

本発明は露光技術に関するもので、特に半導体 用ホトマスクや縮小アライナ用レチクル等に適用 するホトマスクに関するもので、ホトマスクのパ ターン転写時における異物の転写を防止して餌光 できりる技術に関するものである。

〔背景技術〕

半導体装置の製造に多用されるホトリングラフィ工程では、ウエーハ等に形成する素子パターンの原板としてのホトマスクやレチクル(本明細書ではこれらをホトマスクと総称する)が必須のものとされている。ところで、この種のホトマスクをホトリングラフィ技術でパターン転写を行なり場合、ホトマスクの表面や裏面に臨失等の異物が付着しているとパターンと同時にこの異物も転写されてしまいパターン欠陥を生じることになる。

このため、第1図に示すようにホトマスク1の 表、裏面の周囲にスペーサとしての固定フレーム 2、3を固着すると共に、これら各固定フレーム 2、3の周縁に透明な膜4、5を張設することが 考えられる。この構成によれば、異物は膜4、5 には付着してもホトマスク1の表、異面に直接付 着することは防止されるため、この膜4.5とが トマスク1表, 裏面の間隙、換置すれば固定フレーム2, 3の高さをアライナの焦点深度以上の寸法に設定しておけば、異物が転写されることはない。

しかしながら、この構成では一旦膜4.5を構成してしまうと、ホトマスク1を自動外観検査機にかけた場合に膜4,5によって検査光学系に焦点ずれが生じ、自動外観検査ができなくなるという問題が生じる。このため、被転写物における外観検査を行なう等間接的な検査方法をとらざるを得ず、検査時間が長くなると共に評価精度も低くなるという問題があることを本発明者は見い出した。

〔発明の目的〕

本発明の目的はホトマスク表、裏面への異物の付着を防止して異物の転写を防止し得るのはもとより、ホトマスクを自動外観検査機にかけても何等の不具合が生じることなく良好な検査を行なうことができ、これにより半導体製品の歩留りの向上および作業効率の同上を達成することができる

透過膜12を所要のパターン形状に形成している。 このパターン形状の形成は常法としてのホトリン グラフィ技術が適用されているが詳細は省略する。

前記ホトマスク100表, 裏面11a, 11bに は正方形枠状のフレーム13,14を周辺部に取 着している。これらフレーム13,14は、本例 では軟質樹脂材などから全体を蛇腹状に形成して おり、その一端縁をホトマスク10面に接着する ことにより他端縁をホトマスク10の厚さ方向に 位置変化できる。換貫すれば、ホトマスク10を 水平に設置した場合、各フレーム13,14はそ の高さ寸法を変化できるようにしている。そして, これらフレーム13,14の他端縁には夫々薄い 透明樹脂材からなる遮蔽膜15,16を張設し、 夫々ホトマスク10の表。裏面11a,11bを気 密状態にカバーしている。遮蔽膜15、16のフ レーム13,14との接続部には補助フレーム 17, 18を取着しており、フレーム13, 14 ないし遮蔽膜15.16に節度を与えている。

更に、前記フレーム13.14の周囲一部には

ホトマスクを提供することにある。

本発明の前記ならびにそのほかの目的と新規な 特徴は、本明細書の記述および添付図面からあき らかになるであろう。

[発明の概要]

本願において開示される発明のうち代表的なものの概要を簡単に説明すれば、下記のとおりである。

すなわち、ホトマスクにその高さが可変なフレームを取着し、このフレームに透明な遮蔽膜を地着してホトマスクをカバーすることにより、ホトマスクの露光時と外観検査時とでホトマスクと遮蔽膜との間隙を変化させ、これにより異物の転写を防止する一方で自動外観検査を可能にし、半導体製品の歩留りの同上および作業効率の向上を達成するものである。

〔吳施例〕

第2図は本発明の一実施例の一部破断斜視図であり、ホトマスク10は透明ガラス基板11の装面に11aにCr等の金属膜或いはその他の光不

細径のチューブ19,20の一端を接続し、ホトマスク10の表。裏面11a,11bと、フレーム13,14および遮蔽膜15.16とで夫々画成される気密空間21,22に連通させている。これらチューブ19,20には開閉バルブ23,24を介装し、また他端は清浄空気を供給し或いは空気吸引の可能な空気コントローラ25に接続している。

以上の構成によれば、空気コントローラ25の 清浄空気をチューブ19,20を通して気密空間 21,22に供給すれば、空間21,22内は外 気よりも陽圧になり遮蔽膜15,16はフレーム 13,14を伸長させながらホトマスク10の表。 裏面11a.11bから離れ、第3図(A)のように ホトマスク10の表。 裏面11a.11bと遮蔽膜 15,16との間隙寸法を5~15 mx 程度に大き くする。この状態で開閉バルブ23,24を閉成 すれば遮蔽膜15,16はその状態に保たれる。 したがって、このホトマスクをアライナに設置し て所定の露光を行なえば、異物は遮蔽膜15,16 には付着してもホトマスク10の表、裏面11a、 11 bに直接付着することはなく、しかも遮蔽膜 15、16はホトマスクの表、裏面11a、11 bか らアライナの焦点深度以上に離されているために、 この異物が転写されることは全くない。これによ り、異物が転写されることにより生じるバターン 欠陥を確実に防止できる。

一方、ホトマスク10の外観検査時には、開閉バルフ23,24を開いた上で空気コントロラ25により気密空間21,22内の空気をチューブ19,20を通して吸引する。これにより、気密空間21,22内は外気よりも陰圧とされ、第3図(B)のようにフレーム13,14は短縮されかつ遮蔽膜15,16は夫々若干挽まされながらホトマスク10の設、裏面11bに密離された状態とされる。したがって、この状態でボトマスク10を自動外観検査機にかければ、遮蔽膜15,16が検査機の光学系の焦点ずれを生じることはなく、通常のホトマスクの場合と全く同じに自動外観検査を行なうことができる。

マスクの表、裏面との間に気密空間を画成した上でこの気密空間内の空気圧力をコントロールする ことによりホトマスクと遮蔽膜との間隙寸法を変 化できるようにしているので、単に空気の供給、 吸引を行なうだけで露光、外観検査に夫々好適な 状態を作り出すことができる。

以上本発明者によってなされた発明を実施例に もとづき具体的に説明したが、本発明は上記実施 例に限定されるものではなく、その要旨を逸脱し ない範囲で種々変更可能であることはいうまでも ない。たとえば、フレームは伸縮可能であれば他 の構成であってもよく、またこのフレームを伸縮 させる手段は空気圧以外の物理的な手段(たとえ ば熱)を利用してもよい。更に、ホトマスクのガ ラス基板の厚さが充分に厚いときには、パターン の形成されているホトマスクの表面側にのみ遮蔽 膜を形成するようにしてもよい。

〔利用分野〕

以上の説明では主として本発明者によってなされた発明をその背景となった利用分野である半導

以上のことから、このホトマスク構造によれば 欠陥転写の防止を図って半導体製品の歩留の向上 を達成する一方、自動外観検査を可能にして作業 効率の向上を図りかつ評価措度を高いものにでき る。

〔効 果〕

- (1) ホトマスクに高さの可変なフレームを取棄し、このフレームに透明な遊蔽膜を張散してフレームの作用によって遮蔽膜とホトマスク表、裏面との間隙を変化できるように構成しているので、露光時には間険を大にして遮蔽膜上の異物を無点深度外におき異物の転写を防止して欠陥の発生を防止し、半導体歩留の向上を遊成できる。
- (2) 逆に、遮蔽膜とホトマスクとの間隙を小ない し等にすることにより、外観検査機の光学系にお ける魚点ずれを防止でき、これにより自動外観検 査機による検査を可能にして検査にかかわる作業 効率を向上しかつ一方では評価精度を高めること ができる。
- (3) フレームを蛇腹状にしかつ遮蔽膜によりホト

体装置の製造用のホトマスクに適用した場合について脱明したが、それに限定されるものではなく、レチクルはもちろんのこと所謂写真技術に使用する原板の全てに利用できる。

図面の簡単な説明

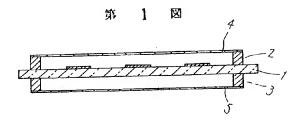
第1図は考えられるホトマスク構造の断面図、 第2図は本発明の一実施例であるホトマスクの 破断斜視図、

第3図(A),(B)は作用を説明するためのホトマスクの断面図である。

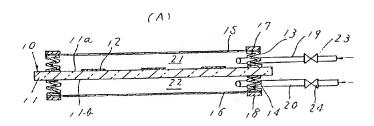
10…ホトマスク、11a,11b…表,裏面、 12…バターン、13,14…フレーム、15, 16…遮蔽膜、17,18…補助フレーム、19, 20…チューブ、21,22…気密空間、23, 24…闘閉バルブ、25…空気コントローラ。

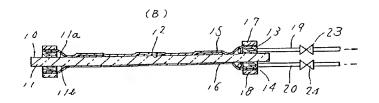
代理人 弁理士 髙 橋 明 夫



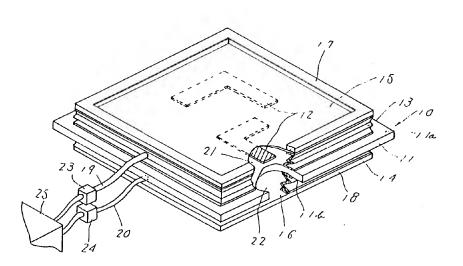


第 3 図





第 2 図



⑲ 日本国特許庁(JP)

⑪特許出願公開

⑩ 公 開 特 許 公 報 (A) 昭60-97356

⑤Int.Cl.⁴

識別記号

庁内整理番号

❸公開 昭和60年(1985)5月31日

G 03 F 1/00

V-7447-2H

審査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

🖾発明の名称

ホトマスク

②特 願 昭58-204803

❷出 願 昭58(1983)11月2日

⑫発 明 者

古泉 裕弘

小平市上水本町1450番地 株式会社日立製作所武蔵工場内

⑪出 願 人 株式会社日立製作所

東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地

砂代 理 人 弁理士 高橋 明夫

外1名

明細 種

発明の名称 ホトマスク

特許請求の範囲

1. ホトマスクにその高さが可変なフレームを取 着すると共に、このフレームには前記パターンを カパーする透明な遮蔽膜を張設し、前記ホトマス クの表面と遮蔽膜との間隙を変化できるように構 成したことを特徴とするホトマスク。

2. ホトマスク表面、フレームおよび遮蔽膜との 間に気密空間を画成し、この気密空間の空気圧を コントロールして前記間膜を変化させてなる特許 請求の範囲第1項記載のホトマスク。

3. フレームを蛇腹状に形成すると共に、空気コントローラに接続したチュープをフレームに開口 連通させてなる特許請求の範囲第2項記載のホト マスク。

発明の詳細な説明

〔技術分野〕

本発明は露光技術に関するもので、特に半導体 用ホトマスクや縮小アライナ用レチクル等に適用 するホトマスクに関するもので、ホトマスクのパ ターン転写時における異物の転写を防止して餌光 できりる技術に関するものである。

〔背景技術〕

半導体装置の製造に多用されるホトリングラフィ工程では、ウエーハ等に形成する素子パターンの原板としてのホトマスクやレチクル(本明細書ではこれらをホトマスクと総称する)が必須のものとされている。ところで、この種のホトマスクをホトリングラフィ技術でパターン転写を行なり場合、ホトマスクの表面や裏面に臨失等の異物が付着しているとパターンと同時にこの異物も転写されてしまいパターン欠陥を生じることになる。

このため、第1図に示すようにホトマスク1の 表、裏面の周囲にスペーサとしての固定フレーム 2、3を固着すると共に、これら各固定フレーム 2、3の周縁に透明な膜4、5を張設することが 考えられる。この構成によれば、異物は膜4、5 には付着してもホトマスク1の表、異面に直接付 着することは防止されるため、この膜4.5とが トマスク1表, 裏面の間隙、換置すれば固定フレーム2, 3の高さをアライナの焦点深度以上の寸法に設定しておけば、異物が転写されることはない。

しかしながら、この構成では一旦膜4.5を構成してしまうと、ホトマスク1を自動外観検査機にかけた場合に膜4,5によって検査光学系に焦点ずれが生じ、自動外観検査ができなくなるという問題が生じる。このため、被転写物における外観検査を行なう等間接的な検査方法をとらざるを得ず、検査時間が長くなると共に評価精度も低くなるという問題があることを本発明者は見い出した。

〔発明の目的〕

本発明の目的はホトマスク表、裏面への異物の付着を防止して異物の転写を防止し得るのはもとより、ホトマスクを自動外観検査機にかけても何等の不具合が生じることなく良好な検査を行なうことができ、これにより半導体製品の歩留りの向上および作業効率の同上を達成することができる

透過膜12を所要のパターン形状に形成している。 このパターン形状の形成は常法としてのホトリン グラフィ技術が適用されているが詳細は省略する。

前記ホトマスク100表, 裏面11a, 11bに は正方形枠状のフレーム13,14を周辺部に取 着している。これらフレーム13,14は、本例 では軟質樹脂材などから全体を蛇腹状に形成して おり、その一端縁をホトマスク10面に接着する ことにより他端縁をホトマスク10の厚さ方向に 位置変化できる。換貫すれば、ホトマスク10を 水平に設置した場合、各フレーム13,14はそ の高さ寸法を変化できるようにしている。そして, これらフレーム13,14の他端縁には夫々薄い 透明樹脂材からなる遮蔽膜15,16を張設し、 夫々ホトマスク10の表。裏面11a,11bを気 密状態にカバーしている。遮蔽膜15、16のフ レーム13,14との接続部には補助フレーム 17, 18を取着しており、フレーム13, 14 ないし遮蔽膜15.16に節度を与えている。

更に、前記フレーム13.14の周囲一部には

ホトマスクを提供することにある。

本発明の前記ならびにそのほかの目的と新規な 特徴は、本明細書の記述および添付図面からあき らかになるであろう。

[発明の概要]

本願において開示される発明のうち代表的なものの概要を簡単に説明すれば、下記のとおりである。

すなわち、ホトマスクにその高さが可変なフレームを取着し、このフレームに透明な遮蔽膜を地着してホトマスクをカバーすることにより、ホトマスクの露光時と外観検査時とでホトマスクと遮蔽膜との間隙を変化させ、これにより異物の転写を防止する一方で自動外観検査を可能にし、半導体製品の歩留りの同上および作業効率の向上を達成するものである。

〔吳施例〕

第2図は本発明の一実施例の一部破断斜視図であり、ホトマスク10は透明ガラス基板11の装面に11aにCr等の金属膜或いはその他の光不

細径のチューブ19,20の一端を接続し、ホトマスク10の表。裏面11a,11bと、フレーム13,14および遮蔽膜15.16とで夫々画成される気密空間21,22に連通させている。これらチューブ19,20には開閉バルブ23,24を介装し、また他端は清浄空気を供給し或いは空気吸引の可能な空気コントローラ25に接続している。

以上の構成によれば、空気コントローラ25の 清浄空気をチューブ19,20を通して気密空間 21,22に供給すれば、空間21,22内は外 気よりも陽圧になり遮蔽膜15,16はフレーム 13,14を伸長させながらホトマスク10の表。 裏面11a.11bから離れ、第3図(A)のように ホトマスク10の表。 裏面11a.11bと遮蔽膜 15,16との間隙寸法を5~15 mx 程度に大き くする。この状態で開閉バルブ23,24を閉成 すれば遮蔽膜15,16はその状態に保たれる。 したがって、このホトマスクをアライナに設置し て所定の露光を行なえば、異物は遮蔽膜15,16 には付着してもホトマスク10の表、裏面11a、 11 bに直接付着することはなく、しかも遮蔽膜 15、16はホトマスクの表、裏面11a、11 bか らアライナの焦点深度以上に離されているために、 この異物が転写されることは全くない。これによ り、異物が転写されることにより生じるバターン 欠陥を確実に防止できる。

一方、ホトマスク10の外観検査時には、開閉バルフ23,24を開いた上で空気コントロラ25により気密空間21,22内の空気をチューブ19,20を通して吸引する。これにより、気密空間21,22内は外気よりも陰圧とされ、第3図(B)のようにフレーム13,14は短縮されかつ遮蔽膜15,16は夫々若干挽まされながらホトマスク10の設、裏面11bに密離された状態とされる。したがって、この状態でボトマスク10を自動外観検査機にかければ、遮蔽膜15,16が検査機の光学系の焦点ずれを生じることはなく、通常のホトマスクの場合と全く同じに自動外観検査を行なうことができる。

マスクの表、裏面との間に気密空間を画成した上でこの気密空間内の空気圧力をコントロールする ことによりホトマスクと遮蔽膜との間隙寸法を変 化できるようにしているので、単に空気の供給、 吸引を行なうだけで露光、外観検査に夫々好適な 状態を作り出すことができる。

以上本発明者によってなされた発明を実施例に もとづき具体的に説明したが、本発明は上記実施 例に限定されるものではなく、その要旨を逸脱し ない範囲で種々変更可能であることはいうまでも ない。たとえば、フレームは伸縮可能であれば他 の構成であってもよく、またこのフレームを伸縮 させる手段は空気圧以外の物理的な手段(たとえ ば熱)を利用してもよい。更に、ホトマスクのガ ラス基板の厚さが充分に厚いときには、パターン の形成されているホトマスクの表面側にのみ遮蔽 膜を形成するようにしてもよい。

〔利用分野〕

以上の説明では主として本発明者によってなされた発明をその背景となった利用分野である半導

以上のことから、このホトマスク構造によれば 欠陥転写の防止を図って半導体製品の歩留の向上 を達成する一方、自動外観検査を可能にして作業 効率の向上を図りかつ評価措度を高いものにでき る。

〔効 果〕

- (1) ホトマスクに高さの可変なフレームを取棄し、このフレームに透明な遊蔽膜を張散してフレームの作用によって遮蔽膜とホトマスク表、裏面との間隙を変化できるように構成しているので、露光時には間険を大にして遮蔽膜上の異物を無点深度外におき異物の転写を防止して欠陥の発生を防止し、半導体歩留の向上を遊成できる。
- (2) 逆に、遮蔽膜とホトマスクとの間隙を小ない し等にすることにより、外観検査機の光学系にお ける魚点ずれを防止でき、これにより自動外観検 査機による検査を可能にして検査にかかわる作業 効率を向上しかつ一方では評価精度を高めること ができる。
- (3) フレームを蛇腹状にしかつ遮蔽膜によりホト

体装置の製造用のホトマスクに適用した場合について脱明したが、それに限定されるものではなく、レチクルはもちろんのこと所謂写真技術に使用する原板の全てに利用できる。

図面の簡単な説明

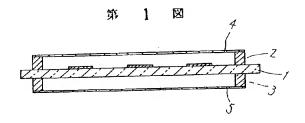
第1図は考えられるホトマスク構造の断面図、 第2図は本発明の一実施例であるホトマスクの 破断斜視図、

第3図(A),(B)は作用を説明するためのホトマスクの断面図である。

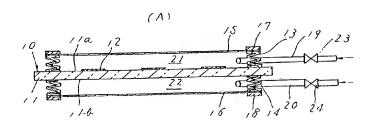
10…ホトマスク、11a,11b…表,裏面、 12…バターン、13,14…フレーム、15, 16…遮蔽膜、17,18…補助フレーム、19, 20…チューブ、21,22…気密空間、23, 24…闘閉バルブ、25…空気コントローラ。

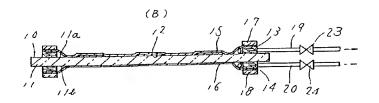
代理人 弁理士 髙 橋 明 夫





第 3 図





第 2 図

